(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11 - 12248

(43)公開日 平成11年(1999) 1月19日

(51) Int .CI . 6	識別記号		FΙ						
C07C321/28		C07C321/28 B01J 21/04							
B01J 21/04						Z			
21/08				21/08		Z			
21/12					Z				
C07C319/14			C07C319/14						
		審査請求	未請求	請求	項の数 6	O L	(全5頁)	最終頁	こ続く
(21)出願番号	特願平9 - 161420		(71)出	71)出願人 000195661					
					住友精化	株式会	社		
(22)出願日	平成 9 年(1997) 6 月18日		兵庫県加古郡播磨町宮西346番地の1						
			(72)発明者 田井 慎一						
					兵庫県加	古郡播	磨町宮西346	番地の 1	住
					友精化株	式会社	第1研究所内	3	
			(72)発	(72)発明者 高島 卓也					
					兵庫県加	古郡播	磨町宮西346	番地の 1	住
					友精化株	式会社	第1研究所内]	
			(72)発	明者	尾上明				
					兵庫県加	古郡播	磨町宮西346	番地の 1	住
					友精化株	式会社	第1研究所内]	
			(74)代	理人	弁理士	吉田	稔 (外1名	3)	
			最終頁に続く						

(54) 【発明の名称】チオアニソールの製造法

(57)【要約】

【課題】 チオフェノールとメタノールとの気相下での触媒反応において触媒の劣化を極力抑え、かつイナート・ガスの生成も抑えるチオアニソールの製造法を提供する。

【解決手段】 チオフェノールとメタノールとを触媒の存在下気相で反応させ、チオアニソールを製造する方法において、触媒を触媒活性を有しない物質で希釈した。好ましくは、上記触媒としては、活性アルミナ、シリカ・アルミナおよびシリカゲルからなる群より選択し、触媒活性を有しない物質としては、 ・アルミナ、ガラスおよび磁器からなる群より選択するとともに、触媒層全体のうちの原料入り口から60%以内の部分の触媒層を触媒活性を有しない物質で15~80%に希釈した。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 チオフェノールとメタノールとを触媒の存在下気相で反応させ、チオアニソールを製造する方法において、触媒を触媒活性を有しない物質で希釈することを特徴とするチオアニソールの製造法。

1

【請求項2】 前記触媒は、活性アルミナ、シリカ-アルミナおよびシリカゲルからなる群より選択される請求項1に記載の製造法。

【請求項3】 触媒活性を有しない物質は、 - アルミナ、ガラスおよび磁器からなる群より選択される請求項 101または2に記載の製造法。

【請求項4】 触媒を触媒活性を有しない物質で15~80%に希釈する請求項1ないし3のいずれか1つに記載の製造法。

【請求項5】 触媒層全体のうちの原料入り口から60%以内の部分の触媒層を希釈する請求項1ないし4のいずれか1つに記載の製造法。

【請求項6】 反応温度が200~400 である請求項1ないし5のいずれか1つに記載の製造法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、チオアニソール (メチルフェニルスルフィド)の製造法に関する。さら に詳しくは、医薬、農薬、光重合開始剤などの原料として、また、除草剤、殺虫剤、各種の溶剤として広範な用途を持つ極めて有用な化合物であるチオアニソールを工業的に有利に製造する方法に関する。

[0002]

[0003]

【本発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記の方法においては、チオフェノールとメタノールとの反応が発熱反応(チオフェノール1モルあたり約14kcalの発熱)であり、反応が激しく進む部分においては局部的に温度が上昇するため、触媒が黒変し、触媒活性の低下を引き起こす結果、触媒寿命の短縮、触媒費用の増加をもたらす。また、局部的に温度が上昇した場合、反応原料として過剰に用いたメタノールの一部が触媒上で熱分解し、一酸化炭素、水素、メタン等の凝縮しにくいガス(以下「イナート・ガス」という)が生成するという問題がある。イナート・ガスの生成は、これらのガスが可燃性であり、空気と混じると爆発混合物を作るためその処理方法に工夫を要し、工業上好ましいことではない。したがって、触媒寿命を伸ばし、イナートガスを

生成することなくチオアニソールを得る方法が望まれて いた。

【0004】そこで、本発明の課題は、チオフェノールとメタノールとの気相下での触媒反応において触媒の劣化を極力抑え、かつイナート・ガスの生成も抑えるチオアニソールの製造法を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題 を解決すべく鋭意検討した結果、以下の知見を得た。 【0006】すなわち、チオアニソールは、活性アルミ ナなどの触媒を充填した反応器に加熱気化したチオフェ ノールとメタノールとの混合蒸気を通気し、200~4 00 で反応させることにより得られる。この反応は通 常、反応器内の触媒層の原料入り口部分から始まるが、 発熱反応であるため触媒層の入り口からの距離が進むに つれて反応温度が上昇し、その温度上昇により相乗的に 反応速度がさらに速まることになる。次いで、反応が進 み原料のチオフェノールとメタノールとが消費されて少 なくなると、反応速度が低下するので、もはや大きな発 熱はなく触媒層の温度は順次低下してくることになる。 このため、反応が激しく進む部分においては反応器内の 触媒層の一部が局部的に高温となるホットスポットが発 生し、このホットスポットにおいては400 を超える 温度に達する。反応温度が400 を超えるとメタノー ルの触媒上での熱分解に由来する一酸化炭素、水素、メ タン等のイナート・ガスの発生が激しくなる。さらに、 反応温度が450 を超えると、副反応が起こりやす く、例えば、ジフェニルスルフィドなどの副生成物が増 加しやすくなる傾向があり、それが触媒毒となって触媒

【0007】以上の知見に基づいて、本発明者らは、触媒に触媒活性を有しない物質を混合することにより単位体積あたりの触媒量を減らす(以下、これを「触媒の希釈」という)ことにより、反応の急速な進行を抑え、ホットスポットの温度上昇を防ぎ、その結果、触媒の劣化が少なく、イナート・ガスの生成も抑えられ、しかも、チオアニソールの生成率の低下を殆ど伴わないことを見出し、本発明を完成した。

【0008】すなわち、本発明は、チオフェノールとメタノールとを触媒の存在下気相で反応させ、チオアニソールを製造する方法において、触媒を触媒活性を有しない物質で希釈することを特徴とするチオアニソールの製造法を提供する。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を詳しく 説明する。

【0010】本発明の方法を実施する際には、図1に示すように、製造装置として、気化ユニット1、反応器2、凝縮器3および蒸留塔4を備えたものを用いる。

ない。したがって、触媒寿命を伸ばし、イナートガスを 50 【0011】気化ユニット1は、原料であるチオフェノ

,

ールとメタノールとを気化させて反応器 2 に導くためのものであり、従来から用いられている種々のものを用いることができる。気化ユニット1においてチオフェノールとメタノールとを気化させる際には、チオフェノールとメタノールとを別々に気化させてもよいし、両者を混合して同時に気化させてもよい。前者の場合は、気化ユニット1として例えば気化器を2つ用い、各気化器でそれぞれ気化されたチオフェノールとメタノールとを別個の経路で反応器 2 に導き、そこで両者を混合するように構成することができる。

【0012】反応器2としては、触媒を充填することができかつ気化反応を実施できるものであれば特に限定されることなく、種々の形状・形態のものを利用することができるが、工業的には、円筒管(カラム)に触媒を充填した充填塔式のものを用いるのが好ましい。

【0013】本発明の製造法で使用される触媒としては、活性アルミナ、シリカ・アルミナ、およびシリカゲルなどが挙げられ、これらの物質からなる群より1または複数種の物質を選択することが好ましく、より好ましくは、活性アルミナが単独で用いられる。

【0014】本発明で用いられる触媒活性を有さない物質(以下「希釈材」という)としては、上記反応に触媒活性を示さないものであれば特に限定されず、例えば、

- アルミナ、ガラス、磁器、金属等が挙げられ、これらの物質からなる群より1または複数種の物質を選択することが好ましく、より好ましくは - アルミナ、ガラス、磁器が用いられる。その形状としては、球状、棒状、円筒状、ドーナツ状、板状等種々の形状のものが使用可能であり、その大きさも限定されるものではない。

【0015】触媒の希釈方法としては種々の方法が考え られるが、具体的には、前記の触媒活性を示さない希釈 材を用いて、触媒全体を均一に希釈しても良いし、局部 的に温度上昇する部分を想定してその部分を重点的に希 釈しても良い。工業的に有利な希釈方法としては、反応 速度論の見地から反応速度が速く発熱が激しい反応器2 内の触媒層の上流側を希釈し、反応速度が低下した下流 側は希釈しないで反応を完結させる方法が挙げられる。 即ち、触媒層全体のうちの原料入り口から60%以内の 部分、好ましくは50%以内の部分の触媒層を希釈する のが好ましい。前述したように、いわゆるホットスポッ トは反応器2の上流側に発生するため、このホットスポ ットに存在する触媒層のみを希釈すれば、全体としての 触媒効率が損なわれることなく反応を進行させることが できる。また、ホットスポットが発生する触媒層のみを 希釈することにより、反応器2の容積の増加、すなわち 反応器2の大型化を最小限に抑制することができる。

【0016】触媒の希釈割合とは、触媒体積(みかけ体積)を触媒と希釈材との合計体積で除したものをいい、通常その値は15~80%、好ましくは20~70%である。触媒の希釈割合が80%より大きいと希釈の効果

が認められず、15%より小さいと触媒層の単位体積あたりの触媒効率が低下し好ましくないからである。

【0017】反応方法としては、垂直に反応器2を起立させ、その上部又は下部から原料を導入する方法、あるいは反応器2を水平とする方法などがあるが、一般的には気化されたチオフェノールとメタノールとを垂直に起立させたカラムの上部からその内部に導き、反応熱を除去しながら反応させる方式を採用するのが好ましい。この場合、反応ガスはカラムの下部より取り出すことがで10 きる。なお、このような反応方式を採用する際には、カラムを複数本用い、各カラムに原料ガスを導くこともできる。このように構成すれば、複数本のカラムで同時に反応させることができるので、より効率的に目的とするチオアニソールを製造することができる。

【0018】なお、反応方法は、好ましい反応収率を達成できるものであれば、前述の方式以外の方式が採用されてもよい。

【0019】触媒に通気する原料のモル比は、チオフェノール1モル当たりメタノール0.5~2.0倍モル、好ましくは1.05~1.5倍モルになるよう設定するのが好ましい。モル比がこの範囲より小さい場合は、チオフェノールを基準としたチオアニソールの収率が低下し、モル比がこの範囲より大きいとそれに比例して空間一時間当たりの収率が増加しにくく、未反応のメタノールが増えるとともにイナート・ガスの発生量も増加するからである。

【0020】反応温度は、使用する触媒の種類により若干異なるが、例えば、活性アルミナを用いた場合には、約200~400 に設定するのが好ましい。反応温度が200 未満の場合は、反応が進行しにくくなり、収率が低下する恐れがある。また、反応速度が遅いので大きな反応器が必要になる。逆に、400 を超えると、副反応、すなわち前述のジフェニルスルフィドなどの副生成物が増加しやすくなる傾向がある。

【0021】反応器2内に於けるガスの空間速度は、原料のモル比や反応温度により若干異なるが、触媒上で良好な気相反応が進行しやすいようにするため、通常、100~200/時間に設定するのが好ましい。

【0022】反応後は、反応生成物を凝縮器3などによって50 以下に冷却し、得られた油層を蒸留塔4などで蒸留することにより、容易に高純度のチオアニソールを得ることができる。

[0023]

【実施例】以下、本発明の実施例を比較例とともに説明するが、本発明はこれらの例に限定されるものではない。なお、説明の便宜上、比較例を先に説明した上で本発明の実施例を説明することにする。

[0024]

通常その値は15~80%、好ましくは20~70%で 【比較例1】メタノール24.2重量%とチオフェノーある。触媒の希釈割合が80%より大きいと希釈の効果 50 ル75.8重量%とからなる混合物を毎時145gの割

4

合で気化器に供給し、約280 のガス状混合物を得 た。

【0025】このガス状混合物を、触媒として活性アル ミナ(水澤化学工業製ネオビードC)が150ml充填 され、かつ熱媒により約300 に維持された反応器に 通じ、2000時間の連続反応を行った。ホットスポッ トの温度は410 でその位置(カラムの入り口からの 距離/カラムの全長)は反応初期には0.10であり、 反応終了時は0.26であった。

【0026】反応器からの反応ガスを凝縮器で約30 に冷却・凝縮させ反応液を得た。この反応液をガスクロ マトグラフィーで分析して原料チオフェノールを基準と したチオアニソールの生成率を求めた。反応開始時のチ オアニソールの生成率は99.5%であったが2000 時間後の生成率は94.7%へと低下した。イナート・ ガスの発生量は反応初期には290m1/時間であり、 反応終了時には380m1/時間に増加した。

[0027]

[0030]

【実施例1】比較例1において、活性アルミナ150m 1の内、原料入り口側部分の75mlについて活性アル 20 ミナ37.5mlにボール状の - アルミナ(岩尾磁器 工業製)37.5mlを混合して50%に希釈した触媒 を充填した反応器を用いた以外は比較例1と同様に20 00時間の反応を行った。

【0028】ホットスポットの温度は370 でその位 置(カラムの入り口からの距離/カラムの全長比)は反 応初期には0.10であり、反応終了時も0.13とほ とんど移動はなかった。

【0029】反応器からの反応ガスを凝縮器で約30 マトグラフィーで分析して原料チオフェノールを基準と したチオアニソールの生成率を求めた。反応開始時のチ オアニソールの生成率は99.3%と比較例1と大差な く、反応終了時においてもチオアニソールの生成率は9 9.3%と、触媒活性の低下が認められなかった。ま た、イナート・ガスの発生量は反応初期の90m1/時 間に対し、反応終了時には80m1/時間と大差なく、 比較例1に対してその発生量は大きく低減されていた。

【実施例2】比較例1において、活性アルミナ150m 40 1 気化ユニット 1の内、原料入り口側部分の40m1について活性アル ミナ14mlにガラス・ビーズ26mlを混合して35 %に希釈した触媒を充填した反応器を用いた以外は比較

例1と同様に反応を行った。

【0031】ホットスポットの温度は350 でその位 置は反応初期には0.12であり、反応終了時も0.1 3とほとんど移動はなかった。

【0032】反応開始時のチオアニソールの生成率は9 9.2%と比較例1と大差なく、反応終了時においても チオアニソールの生成率は99.1%と、触媒活性の低 下が認められなかった。また、イナート・ガスの発生量 は反応初期の50m1/時間に対し、反応終了時には6 10 0 m l / 時間と大差なく、比較例 1 に対してその発生量 は大きく低減されていた。

[0033]

【実施例3】比較例1において、活性アルミナ150m 1の内、原料入り口側部分の75m1について活性アル ミナ15mlに磁性ラシヒ・リング60mlを混合して 20%に希釈した触媒を充填した反応器を用いた以外は 比較例1と同様に反応を行った。

【0034】ホットスポットの温度は335 でその位 置は反応初期には0.33であり、反応終了時も0.3 5とほとんど移動はなかった。

【0035】反応開始時のチオアニソールの生成率は9 9.2%と比較例1と大差なく、反応終了時においても チオアニソールの生成率は99.2%と、触媒活性の低 下が認められなかった。また、イナート・ガスの発生量 は反応初期の30m1/時間に対し、反応終了時も30 m1/時間と変化なく、比較例1に対してその発生量は 大きく低減されていた。

[0036]

【発明の効果】本発明に係るチオアニソールの製造法に に冷却・凝縮させ反応液を得た。この反応液をガスクロ 30 よれば、触媒を触媒活性を有しない化合物で希釈するこ とにより、反応の急速な進行を抑え、ホットスポットの 温度上昇を防ぐ結果、触媒活性を長く保持でき、かつ、 メタノールの分解に由来するイナート・ガスの発生量を 減少できるので、工業的に好ましいチオアニソールの製 造方法を提供することができる。

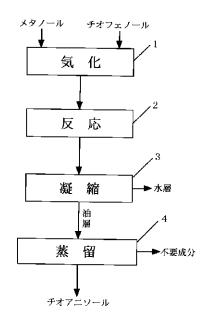
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のチオアニソールの製造法を実施するた めに用いられる装置の一例を表す概略構成図である。

【符号の説明】

- - 2 反応器
 - 3 凝縮器
 - 4 蒸留塔

【図1】



フロントページの続き

 (51) Int .CI.⁶
 識別記号
 FI

 // C 0 7 B 61/00
 3 0 0
 C 0 7 B 61/00
 3 0 0

(72)発明者 畑 啓之

兵庫県加古郡播磨町宮西346番地の1 住 友精化株式会社第1研究所内